

SOT89 NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTORS

ISSUE 3 – FEBRUARY 1996

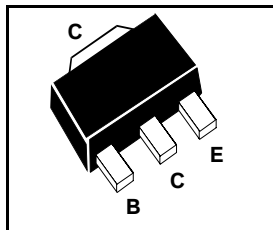
BCX54
BCX55
BCX56

PARTMARKING DETAILS:-

BCX54 – BA	BCX54-10 – BC	BCX54-16 – BD
BCX55 – BE	BCX55-10 – BG	BCX55-16 – BM
BCX56 – BH	BCX56-10 – BK	BCX56-16 – BL

COMPLEMENTARY TYPES:-

BCX54 – BCX51 BCX55 – BCX52 BCX56 – BCX53



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	BCX54	BCX55	BCX56	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	45	60	100	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	45	60	80	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5			V
Peak Pulse Current	I_{CM}	2			A
Continuous Collector Current	I_C	1			A
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	P_{tot}	1			W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-65 to +150			$^{\circ}C$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	45 60 100			V	$I_C = 100\mu A$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	45 60 80			V	$I_C = 10mA^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5			V	$I_E = 10\mu A$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}			0.1 20	μA	$V_{CB} = 30V$ $V_{CB} = 30V, T_{amb} = 150^{\circ}C$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}			20	nA	$V_{EB} = 4V$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$			0.5	V	$I_C = 500mA, I_B = 50mA^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$			1.0	V	$I_C = 500mA, V_{CE} = 2V^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	25 40 25 63 100		250 160 250		$I_C = 5mA, V_{CE} = 2V^*$ $I_C = 150mA, V_{CE} = 2V^*$ $I_C = 500mA, V_{CE} = 2V^*$ $I_C = 150mA, V_{CE} = 2V^*$ $I_C = 150mA, V_{CE} = 2V^*$
Transition Frequency	f_T	150			MHz	$I_C = 50mA, V_{CE} = 10V$, $f = 100MHz$
Output Capacitance	C_{obo}			15	pF	$V_{CB} = 10V, f = 1MHz$

* Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9